

Nomenclatures

λ :	Longitude
Φ :	Latitude
δ :	La déclinaison solaire
W :	Angle horaire
Δ :	Hauteur angulaire du soleil
q :	charge de l'électron $e=1.6*10^{-19}$ coulomb.
T :	température de la cellule (Kelvin).
K :	constante de Boltzmann ($K=1.3854 * 10^{-23}$ J/K).
A :	facteur de qualité de la diode.
I_{ph} :	courant photonique de la diode
I_0 :	courant de saturation de la diode (A)
E :	ensoleillement dans le plan de la cellule (W/m ²).
T :	température de la cellule (°C).
I :	intensité de courant fournie par la cellule (A).
V :	tension aux bornes de la cellule (V).
V_{oc} :	Tension à circuit ouvert
I_{mp}, V_{mp} :	le point de fonctionnement optimal.
P_c :	La puissance de crête
R_{sh} :	résistance shunt
C_j :	capacité de jonction
I_{CE0} :	le courant de fuite
B :	l'amplification du transistor
f :	fréquence de commutation
V_{load} :	La tension aux bornes de la charge
D :	rapport cyclique
Δi_L :	Augmentation du courant i_L
H_t :	l'irradiation journalière
I_{sc} :	courant de court-circuit.
Δi_L :	courant dans l'inductance
I_{PV} :	courant d'entrée
I_{C1} :	courant dans le condensateur
ΔV_{PV} :	L'ondulation de la tension d'entrée
k_V :	facteur de tension

k_I : facteur de courant

h_{femin} : gain minimum de transistor